

吸收磁磁

EMI 吸收磁环/磁珠的吸收干扰能力是用其阻抗特性来表征的。在低频段呈现非常低的感性阻抗值,不影响数据线或信号线上有用信号的传输。在高频段,约为 10MHz 左右开始,阻抗增大,其感抗成分保持很小,电阻性份量却迅速增加,将高频段 EMI 干扰能量以热能形式吸收耗散。通常用两个关键点频率 25MHz 和 100MHz 处电阻值来标定 EMI 吸收磁环/磁珠的吸收特性。

使用方法

EMI 吸收磁环 EMI 吸收磁环常用于抑制电子设备,机械,甚至高档的数据线,电源线、信号线上等等的干扰,同时还具有吸收静电脉冲能力。

- 1、直接套在一根或一束电源、信号线上,为了增加干扰吸收能量,可反复多绕几圈;
- 2、带有安装夹的 EMI 磁环,适用于补偿式的抗干扰抑制;
- 3、可以方便的夹在电源线、信号线上;
- 4、灵活,可重复使用安装;
- 5、自带卡式固定,不影响设备的整体形象。



尺寸选择

EMI 吸收磁环的内外径差值越大,纵向高度越大,其阻抗也就越大,但磁环内径一定要紧包电缆,避免漏磁。

NO	Letm	Unit:mm			Impedance(II)min	
		ΦA	B	ΦC	25MHZ	100MHZ
1	F2 RH2.5*4*0.8	2.5±0.3	4±0.3	0.8±0.2	25	70
2	F2 T 3*1.5*1.5	3±0.3	1.5±0.2	1.5±0.2		25
3	F2 T 3*3*1.2	3±0.3	3±0.3	1.2±0.2		25
4	F2 T 3*3*1.5	3±0.3	3±0.3	1.5±0.2		25
5	F2 T 3.5*2.5*1.8	3.5±0.3	2.5±0.3	1.8±0.2	15	35
6	F2 T 3.5*3*1.2	3.5±0.3	3±0.3	1.2±0.2	20	40
7	F2 T 3.5*3*1.5	3.5±0.3	3±0.3	1.5±0.2	20	40
8	F2 T 3.5*3.5*1.8	3.5±0.3	3.5±0.3	1.8±0.2	20	40
9	F2 T 3.5*4*1.5	3.5±0.3	4±0.3	1.5±0.2	20	40
10	F2 RH3.5*5*1.2	3.5±0.3	5±0.3	1.2±0.2	30	45
11	F2 RH3.5*5*1.5	3.5±0.3	5±0.3	1.5±0.3	25	40
12	F2 RH3.5*5*1.8	3.5±0.3	5±0.3	1.8±0.3	20	40
13	F2 RH3.5*6*1.5	3.5±0.3	6±0.3	1.5±0.3	30	50
14	F2 RH3.5*8*1.5	3.5±0.3	8±0.3	1.5±0.3	40	80
15	F2 RH3.5*9*1.5	3.5±0.3	9±0.3	1.5±0.3	40	80